

沖縄工業高等専門学校	開講年度	令和02年度(2020年度)	授業科目	半導体工学
科目基礎情報				
科目番号	3211	科目区分	専門 / 必修	
授業形態	授業	単位の種別と単位数	履修単位: 1	
開設学科	情報通信システム工学科	対象学年	3	
開設期	後期	週時間数	2	
教科書/教材	半導体デバイス工学—デバイスの基礎から製作技術まで (森北出版),配布資料、PPT			
担当教員	藤井 知			

### 到達目標

- ①半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを説明できる
- ②半導体の種類(真性、不純物、n型、p型、元素、化合物半導体)を理解できる
- ③デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の構造と電気特性を説明できる  
【V-C-4】電子や原子等の基本的性質を理解し、金属や半導体の物性の理解に役立てられる  
【V-C-4】半導体の基本的性質を理解し、pn接合の特性やトランジスタの動作原理等を説明できる

### ルーブリック

	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	最低限必要な到達レベル(可)
半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを説明できる	・半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを定量化的に説明できる	・半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを定性的に説明できる	・教科書を見ながら、半導体と金属・絶縁体の基本的な物性の違いを説明できる
半導体の種類(真性、不純物、n型、p型、元素、化合物半導体)を理解できる	・半導体のエネルギー-band図を描くことができ、キャリア(電子・正孔)の動きを説明できる	・半導体の伝導型によってエネルギー-band図を描くことができ ・半導体の結晶構造を書くことができる	・半導体の種類を、伝導型や結晶構造、材料に分けて説明できる
デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の構造と電気特性を説明できる	・デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の電気特性を特性式を用いて説明できる	・デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の動作原理を定性的に説明できる。	・デバイス(pn接合、バイポーラトランジスタ、MOSFET)の構造を説明できる

### 学科の到達目標項目との関係

#### 教育方法等

概要	・半導体の原理、構造、特性を学び、PN接合、MOS接合、バイポーラ、MOS電界効果トランジスタ、集積回路の各デバイスの構造と特性の基礎を理解する。 ・半導体デバイスの概要を学ぶ。授業ではモデル図、数式を用いた基礎的な学習を行う。 ・演習問題を解きながら理解度を確認する。
授業の進め方・方法	教科書を中心に、関連のビデオ鑑賞や、小テストを講義中に実施する。評価は小テスト・中間・期末試験にて実施する。
注意点	

#### 授業計画

	週	授業内容	週ごとの到達目標
後期	1週	半導体とは? 半導体の役割、半導体デバイスの歴史	半導体とは? 半導体の役割、半導体デバイスの歴史
	2週	半導体の性質	金属や半導体の物性の理解に役立てられる
	3週	半導体のキャリア	キャリア密度、フェルミ準位、エネルギー-bandの意味を理解し、正しくかける 金属や半導体の物性の理解に役立てられる
	4週	半導体の電気伝導度	キャリアの運動、電気伝導、キャリアの生成、再結合を理解し、半導体中のキャリアの流れの等を説明できる
	5週	p型半導体・n型半導体	不純物ドーピングによるキャリアの制御
	6週	pn接合	pn接合の特性やトランジスタの動作原理等を説明できる
	7週	前半復習	金属や半導体の物性の理解し、pnダイオードをバンド図や構造図を用いて説明できる
	8週	後期中間試験	
後期	9週	金属-半導体接触	ショットキー接合・オーミック接合を説明できる。
	10週	pnダイオード	ショットキダイオードの動作原理等をバンド図を用いて説明できる
	11週	バイポーラトランジスタ	バイポーラトランジスタを、構造、エネルギー-band図、電気特性から動作原理等を説明できる
	12週	バイポーラトランジスタ(2)	バイポーラトランジスタの動作原理等を構造、エネルギー-band図、電気特性から説明できる
	13週	MOSデバイス(ダイオードとトランジスタ)	MOS動作である蓄積層、空乏層、反転層を説明できる。
	14週	MOSデバイス(ダイオードとトランジスタ)	MOS動作である蓄積層、空乏層、反転層を説明できる。
	15週	半導体の復習	これまで学んだ半導体に関わる物理・化学の復習
	16週	期末試験	

評価割合							
	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	70	0	0	0	0	30	100
基礎的能力	60	0	0	0	0	20	80
応用力	10	0	0	0	0	10	20
分野横断的能力	0	0	0	0	0	0	0